

⑤

Int. Cl. 2:

B 01 J 17/34

B 01 J 17/20

B 01 J 17/40

⑱ **BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**



DT 25 19 527 A 1

⑪

Offenlegungsschrift 25 19 527

⑳

Aktenzeichen:

P 25 19 527.1-43

㉑

Anmeldetag:

2. 5. 75

㉒

Offenlegungstag:

4. 11. 76

③

Unionspriorität:

③② ③③ ③①

—

⑤④

Bezeichnung:

Verfahren zum Herstellen von homogen-phosphordotiertem einkristallinem Silicium durch Neutronenbestrahlung

⑦①

Anmelder:

Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München

⑦②

Erfinder:

Dietze, Wolfgang, Dipl.-Chem. Dr., 8000 München

Prüfungsantrag gem. § 28 b PatG ist gestellt

DT 25 19 527 A 1

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Berlin und München

München 2, -2. MAI 1975
Wittelsbacherplatz 2

2519527

VPA 75 P 1070 BRD

Verfahren zum Herstellen von homogen-phosphordotiertem einkristallinem Silicium durch Neutronenbestrahlung.-----

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von homogen-phosphordotiertem, einkristallinem Silicium durch Neutronenbestrahlung ohne Nachtemperung des Kristallmaterials zur Ausheilung der durch die Bestrahlung entstandenen Kristallgitterschäden.

Für die Herstellung von hochqualifizierten Halbleiterbauelementen werden Siliciumstäbe mit definiertem Dotierstoffgehalt benötigt. Dabei soll der Dotierstoff entsprechend der gewünschten Dotierstoffkonzentration möglichst homogen über das Stabvolumen in radialer und axialer Richtung verteilt sein.

Bei den in der Halbleitertechnik bekannten Verfahren wird der Dotierstoff entweder mittels eines Trägergasstromes mit der gasförmigen Halbleiterverbindung vermischt auf den, durch Stromdurchgang erhitzten Halbleiterkristallstab geblasen und dort thermisch zersetzt (C-Prozeß), oder mittels eines Trägergasstromes während des tiegelfreien Zonenschmelzens direkt der Schmelzzone zugeführt. Bei letzterem Verfahren werden als Dotierstoffe die gut zu handhabenden, leicht verdampfbaren Verbindungen von Bor und Phosphor verwendet. Die Dosierung der Dotierstoffmenge wird hier über Ventile geregelt. Ein großer Nachteil besteht darin, daß die für die Dosierung verwendeten Ventile nicht genau arbeiten. Darunter leidet die Reproduzierbarkeit der Dotierung der so hergestellten Si-

609845/1020

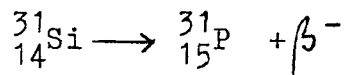
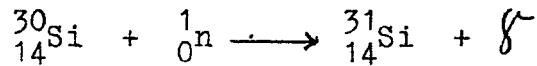
VPA 75 E 1040 a

EdT-12 30m

ORIGINAL INSPECTED

liciumkristallstäbe. Außerdem liefern diese Verfahren und die dazu verwendeten Vorrichtungen eine mehr oder weniger inhomogene Verteilung der Dotierstoffe.

Aus der DT-PS 1 214 789 ist ein Verfahren zum Herstellen von homogen n-dotierten Siliciumkristallkörpern durch Bestrahlung mit thermischen Neutronen entsprechend der Gleichungen



bekannt, bei dem die Dotierung erstmals homogen über den Kristall eingestellt werden konnte. Der Siliciumkristallkörper wird dabei so lange der Neutronenbestrahlung ausgesetzt, bis sich in ihm die gewünschte Phosphormenge durch Kernumwandlung gebildet hat. Durch die Neutronenbestrahlung entstehen aber im Kristallgitter Fehlstellen in Form von Deformationen, welche durch eine anschließende Wärmebehandlung durch einen Temperprozeß wieder beseitigt werden müssen, bevor das dotierte Kristallmaterial zu Halbleiterbauelementen weiterverarbeitet werden kann. Das bestrahlte Material muß also entsprechend der Intensität der vorherigen Einwirkung im Neutronenreaktor in einem Temperofen so lange nachbehandelt werden, bis der durch die Bestrahlung entstandene Schaden beseitigt ist und auch die auf Zwischengitterplätzen sitzenden Phosphoratome in ihre substitutionellen Stellungen zurückgeführt sind. Dies erfordert, wie aus der DT-PS 1 214 789 zu entnehmen ist, Temperzeiten von etwa 24 Stunden bei 1000°C.

Die Erfindung beschreitet einen anderen Weg zur Herstellung von homogen-phosphordotiertem Silicium durch Neutronenbestrahlung und vermeidet den Temperprozeß dadurch, daß zunächst in bekannter Weise durch das thermische Abscheideverfahren aus der Gasphase polykristallines Silicium hergestellt wird, daß eine Probe des poly-

kristallinen Silicium zur Messung der Leitfähigkeit des Ausgangsmaterials in den einkristallinen Zustand übergeführt wird, daß aufgrund der gemessenen Leitfähigkeitswerte der Probe die zur Erzielung der gewünschten Phosphorkonzentration erforderliche Neutronenbestrahlung in Bezug auf Zeit, Ort und Intensität der Strahlung berechnet wird, daß dann das polykristalline Silicium entsprechend der berechneten Werte der Bestrahlung mit thermischen Neutronen ausgesetzt wird und daß im Anschluß an die Bestrahlung das polykristalline, bestrahlte und dadurch phosphordotierte Silicium mit Hilfe eines Keimkristalls in den einkristallinen Zustand übergeführt wird.

Dabei liegt es im Rahmen der Erfindung, daß zur Überführung des polykristallinen, dotierten Silicium in den einkristallinen Zustand das Tiegelziehverfahren nach Czochralski oder aber auch der bekannte tiegelfreie Zonenschmelzprozeß durchgeführt wird. Da bei diesen Prozessen das Kristallmaterial sowieso geschmolzen und in den einkristallinen Zustand mittels eines Keimkristalls übergeführt wird, kann die bei den bekannten Verfahren erforderliche Temperung entfallen.

In einer Weiterbildung des Erfindungsgedankens ist vorgesehen, das polykristalline Silicium aus der Gasphase in Stabform herzustellen und dann die Stäbe während der Neutronenbestrahlung im Reaktor in Rotation um ihre Längsachse zu versetzen. Dadurch wird die Homogenisierung des durch Kernumwandlung erzeugten Dotierstoffes weiter begünstigt.

Gemäß einem Ausführungsbeispiel nach der Lehre der Erfindung wird die Dotierung des polykristallinen Stabes im Reaktor zonenweise vorgenommen, wobei die Dotierungskonzentration über gesteuerte Hub-

bewegungen in Bezug auf die Strahlungsquelle eingestellt wird. Als Strahlungsquelle wird z.B. ein mit einem Neutronenleiter gebündelter Neutronenstrahl, der aus einem Kernreaktor herausgeführt wird, verwendet. Die gewünschte Dotierstoffkonzentration entlang des Stabes wird im wesentlichen durch die über den Antriebsmechanismus auf die Stabhalterung übertragenen gesteuerten Hubbewegungen eingestellt.

In der Figur ist eine Anordnung dargestellt, mittels welcher das Dotierungsmaterial (Phosphor) durch Kernumwandlung des Silicium mit thermischen Neutronen erzeugt wird. Dabei ist ein mit einer Stabhalterung 2 versehener Rezipient 3 dargestellt, der mit einer Neutronenquelle 4 gekoppelt ist. Im Rezipienten 3 befindet sich ein senkrecht stehender, an seinem unteren Ende in der Halterung 2 eingespannter, axial-verschiebbarer und um seine Längsachse drehbarer (s. Pfeile 5), noch undotierter, polykristalliner Siliciumstab 6, der zuvor durch Abscheidung von Silicium aus einer Silicium enthaltenden gasförmigen Verbindung auf einer erhitzten Silicium-Seele hergestellt wurde. Die Erzeugung der Phosphoratome im Stab 6 erfolgt in der Weise, daß der rotierende Siliciumstab 6 am ruhenden in der Neutronenquelle 4 erzeugten Neutronenstrahl 7 vorbeigezogen wird.

Ausführungsbeispiel:

Zur Erzielung eines spezifischen Widerstandes von $200 \Omega \text{cm}$ n-Leitfähigkeit längs eines Siliciumeinkristallstabes von 30 mm Durchmesser sind im polykristallinen Siliciumstab im Reaktor folgende Parameter einzustellen:

Phosphorkonzentration:	$200 \Omega \text{cm}$, entsprechend $2,6 \cdot 10^{13}$ Atome cm^{-3}
Therm. Neutronenfluß:	$2 \cdot 10^{12}$ Neutronen $\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$

Vorschub der Stabhalterung: 0,5 cm/h
Rotationsgeschwindigkeit der
Stabhalterung: 10 Umdrehungen pro Stunde
Leitfähigkeit des Ausgangsmate-
rials
(aufgrund der Widerstandsanalyse): 2000 bis 3000 Ω cm, n-Typ
Bestrahlungszeit der jeweils
bestrahlten Zone: 20 Stunden

Für das anschließende Zonenschmelzen gelten die üblichen Be-
dingungen.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist auch die Möglichkeit ge-
geben, polykristallines oder amorphes Silicium zu dotieren und
für spezielle Zwecke weiterzuverarbeiten. Soll es für elektroni-
sche Bauelemente im polykristallinen Zustand verwendet werden,
muß dann nach der Neutronenbestrahlung noch ein Temperprozeß an-
geschlossen werden, um die entstandenen Fehlstellen im Kristall-
gitter zu beseitigen.

1 Figur

5 Patentansprüche

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Verfahren zum Herstellen von homogen-phosphordotiertem, einkristallinem Silicium durch Neutronenbestrahlung ohne Nachtemperung des Kristallmaterials zur Ausheilung der durch die Bestrahlung entstandenen Kristallgitterschäden, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zunächst in bekannter Weise durch das thermische Abscheideverfahren aus der Gasphase polykristallines Silicium hergestellt wird, daß eine Probe des polykristallinen Silicium zur Messung der Leitfähigkeit des Ausgangsmaterials in den einkristallinen Zustand übergeführt wird, daß aufgrund der gemessenen Leitfähigkeitswerte der Probe die zur Erzielung der gewünschten Phosphorkonzentration erforderliche Neutronenbestrahlung in Bezug auf Zeit, Ort und Intensität der Strahlung berechnet wird, daß dann das polykristalline Silicium entsprechend der berechneten Werte der Bestrahlung mit thermischen Neutronen ausgesetzt wird und daß im Anschluß an die Bestrahlung das polykristalline, bestrahlte und dadurch phosphordotierte Silicium mit Hilfe eines Keimkristalls in den einkristallinen Zustand übergeführt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zur Überführung in den einkristallinen Zustand das Tiegelziehverfahren nach Czochralski durchgeführt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zur Überführung in den einkristallinen Zustand das polykristalline, dotierte Silicium einem tiegelfreien Zonenschmelzprozeß unterworfen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß das polykristalline Silicium aus der
Gasphase in Stabform hergestellt wird und daß die Stäbe während
der Neutronenbestrahlung im Reaktor in Rotation um ihre Längs-
achse versetzt werden.

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß die Dotierung des polykristallinen Sta-
bes im Reaktor zonenweise vorgenommen wird, wobei die Dotierungs-
konzentration über gesteuerte Hubbewegungen des Stabes in Be-
zug auf die Strahlungsquelle eingestellt wird.

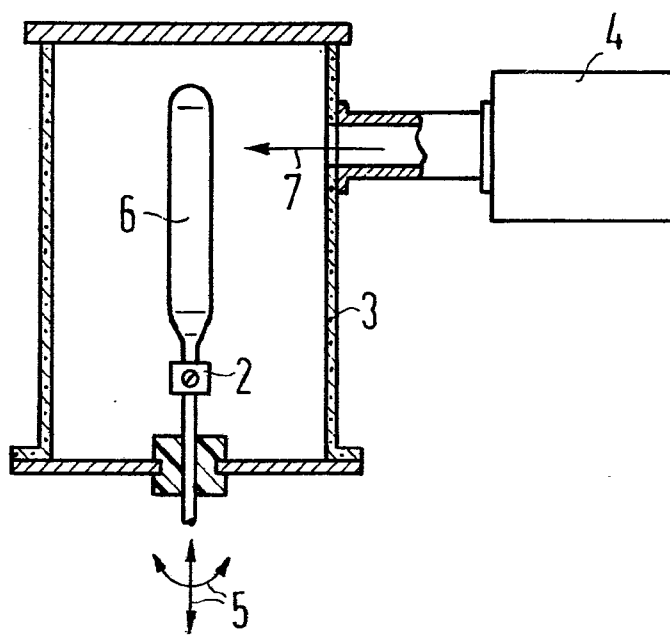
8
Leerseite



... ..

LA 20000

...



B01J

17-34

AT:02.05.1975 OT:04.11.1976

Siemens AG

609845/1020

ORIGINAL INSPECTED